

中国闪存市场评测中心

方案：Samsung NAND Flash+SMI 主控

规范：UHS-I，传输模式:SDR104

产品:Micro SD 卡，容量:128GB，速度等级:Class 10

产品测试报告

报告编号:CFM-TD14100303

中国闪存市场

产品测试时间：2014/09/05

报告生成时间：2014/10/03

中国闪存市场为您传递最前沿的市场信息，提供全面、准确的存储市场数据报告，深度解析存储市场行情，提供最新的市场动向、新品展示，全方位提供最专业的市场咨询服务。

版权所有请勿以任何形式转载、传输、重制、出版或播送，若有任何疑问请与我们联系。

Copyright 深圳市闪存市场资讯有限公司 All rights reserved.

免责声明：中国闪存市场网产品评测报告的所有内容和数据仅供客户参考，不可作客户产品交易、评比、选型等标准，若因该报告造成任何损失、伤害以及纠纷，中国闪存市场网不会承担任何责任。

目录

一、测试样品参数.....	1
二、测试项目.....	1
三、VTE 测试.....	2
3.1、VTE 测试环境.....	2
3.2、VTE 测试内容和结果.....	2
四、Performance 测试.....	3
4.1、测试环境.....	3
4.2、HDBENCH 软件测试.....	4
4.3、ATTO 软件测试.....	4
4.4、H2Test 软件测试.....	5
4.5、CrystalDiskMark 软件测试.....	5
4.6、Iometer 软件测试.....	5
五、电气性能测试.....	6
5.1、测试环境.....	6
5.2、ATTO 软件测试.....	6
六、兼容性测试.....	7
七、老化测试.....	9
7.1、测试环境.....	9
7.2、BurnIn 测试内容及结果.....	9
八、Power Cycle 测试.....	10
8.1、测试环境.....	10
8.2、测试内容及结果.....	10

一、测试样品参数

SD 卡 128GB 样品参数			
主控: SMI		Flash: Samsung	
规范: UHS-I		速度等级: Class 10	传输模式: SDR104
容量	文件系统: exFAT		
	已用空间:	393,216 字节	384 KB
	可用空间:	126,934,974,464 字节	118 GB
	容量:	126,935,367,680 字节	118 GB
文件编号: CFM-TD14100303		数量: 18 片	测试日期: 2014-09-05

二、测试项目

	测试项目	测试内容及输出结果					
1	VTE 测试	VTE-SDR104	WMB Sequential =23.57MB/S				
			RMB Sequential =75.85MB/S				
2	Performance 测试	HDbench[MB/S]	Read	Write	Random Read	Random Write	
			71.8	22.91	27.01	7.75	
3	电气性能测试	待机电流[μ A] $x \leq 500 \mu$ A	查看 18 片待机电流均在 0.252 μ A 左右				
		工作电流[mA]	I(w)min	I(w)max	I(r)min	I(r)max	
			77.34	144.96	47.89	158.79	
4	兼容性测试	不同应用平台上的兼容性	OK				
5	产品老化测试	通过在不同环境下连续逻辑写、文件读写、或只读测试样品工作寿命	BurnIn 测试 (空盘)				
			样品编号	Duration	cycle	Error	测试环境
			1#	13h38m	332	0	常温
			2#	13h38m	343	0	常温
			3#	18h10m	505	0	常温
			4#	18h10m	525	0	常温
			5#	42h35m	1234	0	常温
6	Power Cycle 测试	文件方式	1 片 1027 次 OK, 无新增坏块				
		扇区方式	2 片 1299 次、2399 次 OK, 无新增坏块				

三、VTE 测试

3.1、VTE 测试环境

电脑编号	主板芯片组	CPU	内存	操作系统
EQ01-793	Intel G41+ ICH7/R	Intel Pentuim E5200	2GB DDR2	Win7
测试平台	Testmetrix VTE3100 Version 3.1S			
测试脚本	SD_Card(Spec3.0_High&Extended-Capacity_UHS-I and Non-UHS-I)_Compliance [rev32A].vte], VTE11549, EMMC1177, 3.2A, Patch 1a-b71 (SW 3.2A)			
测试数量	1 片及以上			
测试目的	主要包括 SD 协议测试、Speed class 以及各种频宽最高读写速度			

3.2、VTE 测试内容和结果

VTE Compliance	Class10 Pass					
VTE Performance	最高频宽最高读写速度	CARD MODE	Clock rate	WMB Sequential =23.57MB/S		
		SDR104	208MHz	RMB Sequential =75.85MB/S		
Speed Class	Class10@40MHZ					
	card size		Full			
	Performance Move		Not Defined			
	Pw	Write speed	Class 10 @ 40MHZ		Pw =16.49MB/S	
	Pr	Read speed			Pr =19.10MB/S	
	Tfw	FAT Write Time	SPEC		Tfw (ave)	Tfw (max)
		实时记录中 FAT 表更新时间测试	Tfw(avg) <= 100(ms) Tfw(max) <= 750(ms)		5.74ms	35.76ms
	Tfr	Tfr(4KB)max 访问 4KB FAT 目录最大时间	Tfr(4KB) <= 12(ms)		Tfr = 2.47ms	
Pc		20MHz	Pc25%	Pc50%	Pc75%	
			(MB/S)	(MB/S)	(MB/S)	
			—	—	—	

Read/ Write Current	Write Current (SD3.0)	通过 CT 报告, 分别查找 SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 写电流值 @ VDD=3.6V; 1.8V Signaling	I(w)SDR12=	59.60mA
			I(w)SDR25=	119.90mA
			I(w)SDR50=	138.40mA
			I(w)SDR104=	——
	Read Current (SD3.0)	通过 CT 报告, 分别查找 SDR12/SDR25/SDR50/SDR104 读电流值 @ VDD=3.6V; 1.8V Signaling	I(r)SDR12=	33.80mA
			I(r)SDR25=	95.60mA
			I(r)SDR50=	145.40mA
			I(r)SDR104=	——
Write Current (SD2.0)	通过 CT 报告查找 25MHz 写电流 @VDD=3.6V, 3.3V Signaling	I(w)25MHz=	56.18mA	
Read Current (SD2.0)	通过 CT 报告查找 25MHz 读电流 @VDD=3.6V, 3.3V Signaling	I(r)25MHz=	33.43mA	

四、Performance 测试

4.1、测试环境

电脑编号	主板芯片组	CPU	内存	操作系统
CSH-290	ID0C00+ID8C44	Intel Core i5-4670K	4GB DDR3	Win7
读卡器型号	RTS5308、GL828			
测试数量	3 片及以上			
测试目的	通过不同测试条件及环境下测试产品的读写性能是否达标, 产品符合设计标准			
测试工具	<input checked="" type="checkbox"/> HDbench <input checked="" type="checkbox"/> ATTO <input checked="" type="checkbox"/> H2test <input checked="" type="checkbox"/> Crystal Disk Mark <input type="checkbox"/> Flash Disk Test <input checked="" type="checkbox"/> Iometer <input type="checkbox"/> HD_Speed			
测试结果汇总	以上勾选的测试工具测试产品读写速度均 OK, 符合 SPEC 标准。 抽取其中 1 片量产直接测试 HDbench 速度如下			
	Read[MB/S]	Write[MB/S]	RandomRead[MB/S]	RandomWrite[MB/S]
	71.8	22.91	27.01	7.75

4.2、HDBENCH 软件测试

测试工具: HDBench V3.40, 测试 size 选择 100MB 文件, SD3.0 样品需要测试 500MB。



PC 拷贝 OK 格式化拔插后测试



不拔插再次测试



4.3、ATTO 软件测试

测试工具: ATTO V2.40, Transfer Size 选择 4~2048KB, Total Length 选择 128MB



4.4、H2Test 软件测试

测试工具: H2test V1.4, 测试 size 选择全盘(测试速度选择 200MB 即可)

Writing 5000 MByte 3:54 min 21.3 MByte/s	Verifying 5000 MByte 1:16 min 65.3 MByte/s	Writing 5000 MByte 3:56 min 21.2 MByte/s	Verifying 5000 MByte 1:16 min 65.5 MByte/s
Warning: Only 5000 of 121055 MByte tested. Test finished without errors. You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 21.3 MByte/s Reading speed: 65.3 MByte/s H2testw v1.4		Warning: Only 5000 of 121055 MByte tested. Test finished without errors. You can now delete the test files *.h2w or verify them again. Writing speed: 21.2 MByte/s Reading speed: 65.5 MByte/s H2testw v1.4	

4.5、CrystalDiskMark 软件测试

测试工具: CrystalDiskMark V3.03

All	5	100MB	J: 0% (0/118GB)	All	5	100MB	J: 0% (0/118GB)		
	Read [MB/s]		Write [MB/s]		Read [MB/s]		Write [MB/s]		
Seq	78.04		26.14		Seq	78.55		26.10	
512K	65.70		48.00		512K	65.83		42.03	
4K	3.129		1.385		4K	3.098		1.383	
4K QD32	3.487		1.828		4K QD32	3.463		1.786	

4.6、Iometer 软件测试

测试工具: IOMeter 2008, 测试 100MB Disk Size: 204800 sectors

Transfer Size 选择 4KB、百分百 Random 写/读, 选择 512KB、百分百 Sequential 写/读测试, 测试时间: 每项 10min。

Access Specification Name	Iops	MBps
4k random write	410.746884	1.60448
4k random read	925.623192	3.615716
512k sequential write	36.399916	18.199958
512k sequential read	39.475803	19.737901

五、电气性能测试

5.1、测试环境

电脑编号	主板芯片组	CPU	内存	操作系统
CSH-212	AMD 870+SB850	AMD Fx(tm)-4100@3.60GHz	4GB DDR3	Win7
读卡器型号	RTS5308			
电流表型号	FLUKE 289C			
测试数量	5 片及以上			
测试目的	主要测试不同条件、不同测试设备、工具测试其待机电流、工作电流变化			
测试工具	<input checked="" type="checkbox"/> ATTO <input type="checkbox"/> H2test <input type="checkbox"/> Iometer 已勾选测试工具为 SD 卡项目主用测试工具；未测试工具用于测试特殊情况下结果参考及校验。			

5.2、ATTO 软件测试

测试工具：ATTO V2.40

Transfer Size 选择 4~2048KB，Total Length 选择 128MB。

测试项目	数量	测试内容
待机电流(PC 上盘后)	全部	上盘后，记录样品的待机电流值 I(Passive)
写电流范围	3 片及以上	ATTO 测试，记录工作写最低、最高电流值 I(w)min~I(w)max
读电流范围	3 片及以上	ATTO 测试，记录工作读最低、最高电流值 I(r)min~I(r)max
工作电流(max)	3 片及以上	ATTO 测试，记录读写工作中最大电流值 I(w/r)max
待机电流(读写后)	3 片及以上	读写测试后，记录样品的待机电流值 I(Passive)读写后

测试结果

编号	I(p) [mA]	I(w)min [mA]	I(w)max [mA]	I(r)min [mA]	I(r)max [mA]	I(w/r)max [mA]	I(p)读写后 [mA]
1#	0.251	77.34	142.69	48.32	151.66	156.43	0.289
2#	0.259	79.73	144.68	47.89	158.79	167.56	0.331
3#	0.275	79.36	144.96	48.58	154.98	158.94	0.341
待机电流	共查看 18 片样品待机电流均在 0.252mA 左右						

六、兼容性测试

手机型号: Sony L50u、Nokia Lumia630、Coolpad 9970、Samsung S5、Samsung G3819D、Samsung G3518、Nokia Lumia520、Nokia I520、索尼 DV HDR-CX180, 每部设备测试 2~3 片样品。

测试编号	测试项目	测试内容
8-1	识别卡	设备能够自动侦测到卡插入并识别, 读取容量正常。
8-2	热拔插(部分手机)	在通电状态下拔插卡, 设备能正常识别卡(设备支持热拔插的前提下)。
8-3	格式化	1)在设备中, 选择对存储卡进行格式化操作。 2)检查格式化后卡容量和功能是否正常。
8-4	拍照	1)选择最高品质质量格式, 存储路径为存储卡, 每组连续拍照 20 张, 一共拍 2 组。 2)拍照过程中无停顿, 能正常保存。
8-5	预览照片	浏览照片无丢失、无马赛克等情况。
8-6	录像	1)选择最高品质质量格式, 存储路径为存储卡, 录像 20 分钟以上。 2)能正常录像, 保存。
8-7	播放录像	完成后播放录像画面无停顿变音、无马赛克等情况。
8-8	删除文件	1)删除单个、多个、大容量的文件。 2)删除后容量空间释放。
8-9	待机唤醒	设备在进入待机后, 唤醒, 检查卡是否还能正常识别, 读取卡中文件正常。反复测试 20 次。
8-10	数据传输	1)通过 USB 线与 PC 连接, 作为读卡器, 往存储卡中拷贝各种类型文件。 2)安全拔插后用 compare 工具与源文件进行对比是否匹配。
8-11	查看新增坏块	以上所有项目测试完成后, 查看样品是否有新增坏块。

测试结果

Item	Manufacture	Model Name	测试项目												
			8-1	8-2	8-3	8-4	8-5	8-6	8-7	8-8	8-9	8-10	8-11	8-12	
1	Sony	L50u	PASS		无										
2	Nokia	Lumia630	PASS		无										
3	Coolpad	9970	PASS		无										
4	Samsung	S5	PASS		无										
5	Samsung	G3819D	PASS		无										
6	Samsung	G3518	PASS		无										
7	Nokia	Lumia520	PASS		无										

8	Nokia	I520	PASS		无									
9	Sony	HDR-CX180	PASS		无									
测试备注说明		以上设备均测试 OK												

DV 碎化后兼容性测试（使用 Fragment_Tool 进行碎化后再测试）

测试数量	2pcs													
测试条件	2 片均为拷贝 OK 格式化 OK 后碎化													
测试编号	测试项目	测试内容												
8-12	样品碎化	分别抽取量产后及拷贝 OK 后的样品首先使用 Fragment_Tool 工具进行碎化，Block size 选择 4MB，碎化 OK 后可用空间还剩一半。												
8-13	识别卡	设备能够自动侦测到卡插入并识别，读取容量正常。												
8-14	拍照	1)选择最高品质质量格式，存储路径为存储卡，每组连续拍照 20 张，一共拍 2 组。 2)拍照过程中无停顿，能正常保存。												
8-15	预览照片	浏览照片无丢失、无马赛克等情况。												
8-16	录像	1)选择最高品质质量格式，存储路径为存储卡，录像最长时间 158min。 2)能正常录像 30min，保存。												
8-17	播放录像	完成后播放录像画面无停顿变音、无马赛克等情况。												
8-18	删除文件	1)删除单个、多个、大容量的文件。 2)删除后容量空间释放。												
8-19	待机唤醒	设备在进入待机后，唤醒，检查卡是否还能正常识别，读取卡中文件正常。反复测试 20 次。												
8-20	格式化 (碎化后所有功能测试完成后)	1)在设备中，选择对存储卡进行格式化操作。 2)检查格式化后卡容量和功能是否正常。												
8-21	查看新增坏块	以上所有项目测试完成后,查看样品是否有新增坏块。												

测试结果

Item	Manufacture	Model Name	测试项目										备注	
			8-12	8-13	8-14	8-15	8-16	8-17	8-18	8-19	8-20	8-21		
1	SONY	HDR-CX180	PASS	无	拷贝后									
2	SONY	HDR-CX180	PASS	无	拷贝后									

七、老化测试

7.1、测试环境

电脑编号	主板芯片组	CPU	内存	操作系统
CSH-290	ID0C00+ID8C44	Intel Core i5-4670K	4GB DDR3	Win7
CSH-212	AMD 870+SB850	AMD Fx(tm)-4100@3.60GHz	4GB DDR3	Win7
读卡器型号	RTS5308			
测试数量	5片及以上			
测试目的	通过在不同环境下连续逻辑写、文件读写、或只读测试样品工作寿命			
测试工具	<input checked="" type="checkbox"/> BurnInTest <input checked="" type="checkbox"/> H2test <input type="checkbox"/> TF-DataTest <input type="checkbox"/> 5000个小文件 已勾选测试为所有方案搭配必须测试项目； 未测试工具用于测试异常情况下结果校验，或个别方案重点验证。			

7.2、BurnIn 测试内容及结果

测试工具：BurnIn test V6.0，测试数据：Default，测试 size：64KB/1024KB，测试比例：1%，测试时间：13 小时以上，测试完成后拷贝全盘测试，并测试其 Hdbench 速度，以上全部测试完成后查看样品是否有新增坏块。

样品编号	Duration	cycle	Error	备注	测试环境	盘内预留文件	电脑编号
1#	13h38m	332	0	默认数据	常温	无	CSH-293
2#	13h38m	343	0	默认数据	常温	无	CSH-293
3#	18h10m	505	0	默认数据	常温	无	CSH-290
4#	18h10m	525	0	默认数据	常温	无	CSH-290
5#	42h35m	1234	0	默认数据	常温	无	CSH-293
6#	52h39m	1451	0	默认数据	常温	无	CSH-293
测试完成后拷贝测试	OK		——				
查看新增坏块	无		——				

八、Power Cycle 测试

8.1、测试环境

电脑编号	主板芯片组	CPU	内存	操作系统
EQ01-793	Intel G41+ ICH7/R	Intel Pentuim E5200	2GB DDR2	Win7
读卡器型号	RTS5308			
测试数量	2 片及以上			
测试目的	验证产品在反复上、断电或意外拔插后能够正常使用			
测试项目	<input checked="" type="checkbox"/> 文件方式超稳 <input checked="" type="checkbox"/> 扇区超稳 已勾选测试为所有方案搭配必须测试项目；			
测试结果汇总	文件方式	1 片 1027 次 OK, 无新增坏块		
	扇区方式	2 片 1299 次、2399 次 OK, 无新增坏块		

8.2、测试内容及结果

文件系统方式自动超稳定, V2.0.4.7 版本, 选择是否预存文件 (包含碎化), 设置选择固定文件 100MB, 测试次数 1000 次以上

编号	次数	输出结果	是否预先存储文件	自动超稳定后全盘拷贝测试	查看新增坏块
1	1027	OK	无	OK	无

超稳定拷贝全盘测试后, HDbench 软件速度测试



扇区自动超稳定, V1.8.11 版本, 测试次数 1000 次以上, 地址: 10M-

编号	次数	输出结果	自动超稳定后全盘拷贝测试	查看新增坏块
1	1299	OK	OK	无
2	2399	OK	OK	无

超稳定拷贝全盘测试后, 测试 HDbench 速度



联系方式:

出版单位: 深圳市闪存市场资讯有限公司

客服电话: 0755-86133027

传真: 0755-86185012

Email: Service@Chinaflashmarket.com

地址: 深圳市高新区中区科技中二路软件园一期4栋6楼

版权所有请勿以任何形式转载、传输、重制、出版或播送, 若有任何疑问请与我们联系。

Copyright 深圳市闪存市场资讯有限公司 All rights reserved.